

Список публикаций официального оппонента, Александра Борисовича Федорцова, по теме диссертации Кен О.С.

1. В.Б. Воронков, А.С. Иванов, К.Ф. Комаровских, Д.Г. Летенко, **А.Б. Федорцов**, Ю.В. Чуркин. Контроль объемного времени жизни и скорости поверхностной рекомбинации носителей заряда в полупроводниках методом инфракрасного лазерного зондирования // Журнал технической физики. – 1991. – Т. 61. – № 2. – С. 104-108.
2. А.Г. Арешкин, Л.Е. Воробьев, А.С. Иванов, К.Ф. Комаровских, Д.Г. Летенко, **А.Б. Федорцов**, Ю.В. Чуркин. Бесконтактный лазерный интерференционный метод неразрушающего исследования рекомбинационных характеристик электронов и дырок в полупроводниках // Изв. РАН, сер. физическая. – 1992. – Т. 56. – №. 12. – С. 121-129.
3. **A.B. Fedortsov**, D.G. Letenko, Y.V. Churkin, L.M. Tsentsiper, J. Vedde. Bulk lifetime and surface recombination measurements on high purity silicon by a laser modulation technique // Proceedings of the Fourth International Symposium on High Purity Silicon. – The Electrochemical Society, 1996. – Т. 96. – №. 13. – С. 481-489.
4. **A.B. Fedortsov**, D.G. Letenko, Y.V. Churkin, L.M. Tsentsuoer, J. Vedde. Bulk lifetime determination in high purity silicon by contactless laser technique // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 1997. – Т. 8. – №. 3. – С. 213-216.
5. Г.Л. Климчицкая, **А.Б. Федорцов**, Ю.В. Чуркин, В.А. Юрова. Давление силы Казимира на слой диэлектрика в структурах металл – диэлектрик – полупроводник // Физика твердого тела. – 2011. – Т. 53. – №. 9. – С. 1820-1825.
6. **A.B. Fedortsov**, V.A. Yurova. Dispersion forces in nanoscale structures metal-dielectric-semiconductor, in: Nanoscale-Arranged Systems for Nanotechnology. / Ed. by K.L. Levine. – NY, Nova Science Publishers Inc., 2015. – 183 p.
7. В.В. Манухов, **А.Б. Федорцов**, А.С. Иванов. Лазерно-интерференционный метод определения длины диффузии носителей заряда в полупроводниках // Физика и техника полупроводников. – 2015. – Т. 49. – №. 9. – С. 1153-1159.